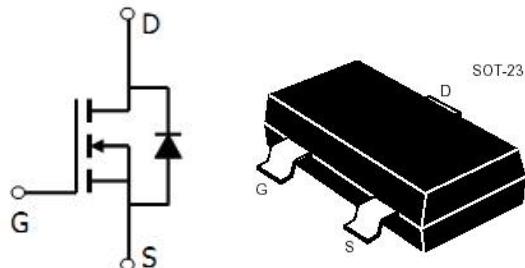


GML0060

SOT-23 場效應晶體管(SOT-23 Field Effect Transistors)



### N-Channel Enhancement-Mode MOS FETs

N 溝道增強型 MOS 場效應管

#### ■MAXIMUM RATINGS 最大額定值

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Rat 額定值	Unit 單位
Drain-Source Voltage 漏極-源極電壓	$BV_{DSS}$	60	V
Gate- Source Voltage 柵極-源極電壓	$V_{GS}$	$\pm 20$	V
Drain Current continuous 漏極電流-連續	$I_{DR}$	2.7	A
Drain Current-pulsed 漏極電流-脉冲	$I_{DRM}$	6	A

#### ■THERMAL CHARACTERISTICS 热特性

Characteristic 特性	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Total Device Dissipation 總耗散功率 $T_A=25^\circ\text{C}$ 環境溫度為 $25^\circ\text{C}$	$P_D$	1050	mW
Derate above $25^\circ\text{C}$ 超過 $25^\circ\text{C}$ 遞減		3.8	$\text{mW}/^\circ\text{C}$
Thermal Resistance Junction to Ambient 热阻	$R_{\theta JA}$	150	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Junction and Storage Temperature 結溫和儲存溫度	$T_J, T_{stg}$	150°C, -55 to +150°C	



GML0060

### ■DEVICE MARKING 打標

GML0060=E10

### ■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

( $T_A=25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為  $25^\circ\text{C}$ )

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 單位
Drain-Source Breakdown Voltage 漏極-源極擊穿電壓( $I_D = 250\mu\text{A}$ , $V_{GS} = 0\text{V}$ )	$\text{BV}_{DSS}$	60	—	—	V
Gate Threshold Voltage 柵極開啓電壓( $I_D = 250\mu\text{A}$ , $V_{GS} = V_{DS}$ )	$V_{GS(\text{th})}$	1	—	2.5	V
Diode Forward Voltage Drop 內附二極管正向壓降( $I_{SD}=1\text{A}$ , $V_{GS}=0\text{V}$ )	$V_{SD}$	—	—	1.5	V
Zero Gate Voltage Drain Current 零柵壓漏極電流( $V_{GS}=0\text{V}$ , $V_{DS}=60\text{V}$ )	$I_{DSS}$	—	—	1	$\mu\text{A}$
Gate Body Leakage 柵極漏電流( $V_{GS}=\pm 20\text{V}$ , $V_{DS}=0\text{V}$ )	$I_{GSS}$	—	—	$\pm 100$	nA
Static Drain-Source On-State Resistance 靜態漏源導通電阻( $I_D=2.7\text{A}$ , $V_{GS}=10\text{V}$ ) ( $I_D=2\text{A}$ , $V_{GS}=4.5\text{V}$ )	$R_{DS(\text{ON})}$	—	—	92 116	$\text{m}\Omega$
Input Capacitance 輸入電容 ( $V_{GS}=0\text{V}$ , $V_{DS}=25\text{V}$ , $f=1\text{MHz}$ )	$C_{ISS}$	—	—	550	pF
Common Source Output Capacitance 共源輸出電容( $V_{GS}=0\text{V}$ , $V_{DS}=25\text{V}$ , $f=1\text{MHz}$ )	$C_{OSS}$	—	—	125	pF
Turn-ON Time 开啓時間 ( $V_{DS}=30\text{V}$ , $I_D=200\text{mA}$ , $R_{GEN}=25\Omega$ )	$t_{(\text{on})}$	—	—	40	ns
Turn-OFF Time 短斷時間 ( $V_{DS}=30\text{V}$ , $I_D=200\text{mA}$ , $R_{GEN}=25\Omega$ )	$t_{(\text{off})}$	—	—	80	ns

- FR-5= $1.0 \times 0.75 \times 0.062\text{in.}$
- Alumina= $0.4 \times 0.3 \times 0.024\text{in.}$  99.5%alumina.
- Pulse Width $\leq 300\mu\text{s}$ ; Duty Cycle $\leq 2.0\%$ .